



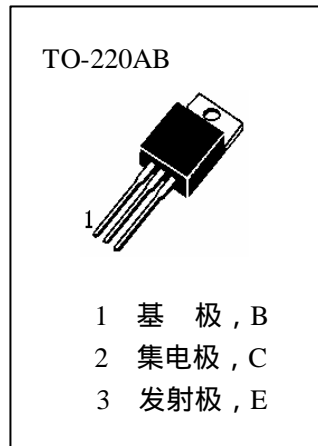
主要用途

高压快速开关

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-65~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率 ($T_c=25$)	100W
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	700V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	400V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	9V
I_C ——集电极电流 (DC)	12A
I_B ——基极电流.....	6A

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	400			V	$I_C=10mA, I_B=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			1	mA	$V_{EB}=9V, I_C=0$
$H_{FE}(1)$	直流电流增益	8		40		$V_{CE}=5V, I_C=5A$
$H_{FE}(2)$		6		30		$V_{CE}=5V, I_C=8A$
$V_{CE(sat1)}$	集电极—发射极饱和电压			1	V	$I_C=5A, I_B=1A$
$V_{CE(sat2)}$				1.5	V	$I_C=8A, I_B=1.6A$
$V_{CE(sat3)}$				3	V	$I_C=12A, I_B=3A$
$V_{BE(sat1)}$	基极—发射极饱和电压			1.2	V	$I_C=5A, I_B=1A$
$V_{BE(sat2)}$				1.6	V	$I_C=8A, I_B=1.6A$
C_{ob}	共基极输出电容		180		pF	$V_{CB}=10V, f=0.1MHz$
f_T	特征频率	4			MHz	$V_{CE}=10V, I_C=0.5A$
t_{on}	导通时间			1.1	μS	} $V_{CC}=125V, I_C=8A$ $I_{B1}=-I_{B2}=1.6A$
t_{stg}	贮存时间			3	μS	
t_f	下降时间			0.7	μS	



特性曲线

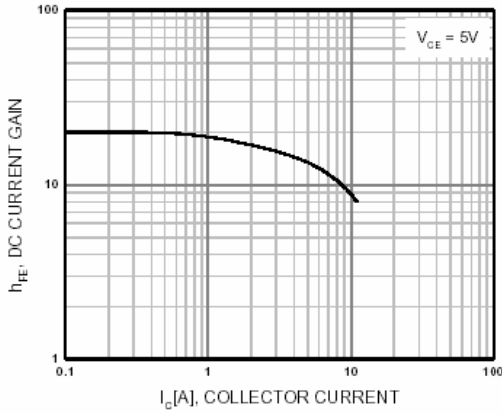


Figure 1. DC current Gain

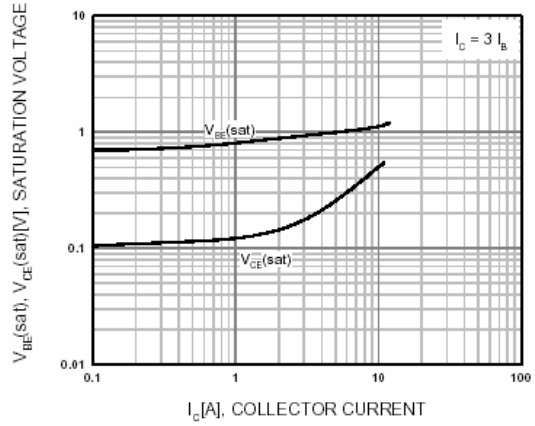


Figure 2. Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage

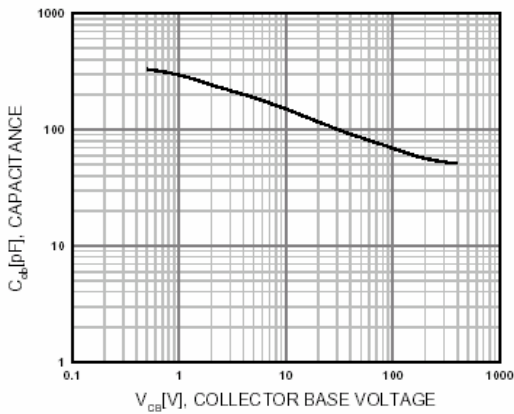


Figure 3. Collector Output Capacitance

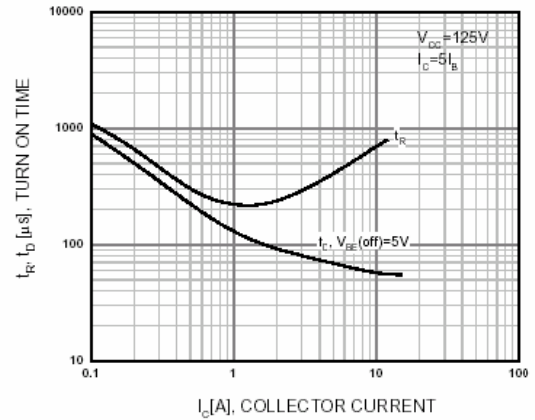


Figure 4. Turn On Time

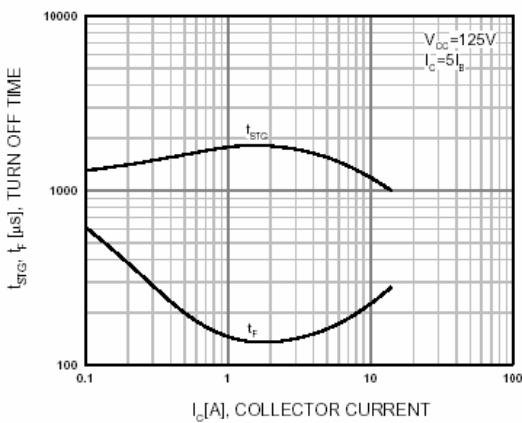


Figure 5. Turn Off Time

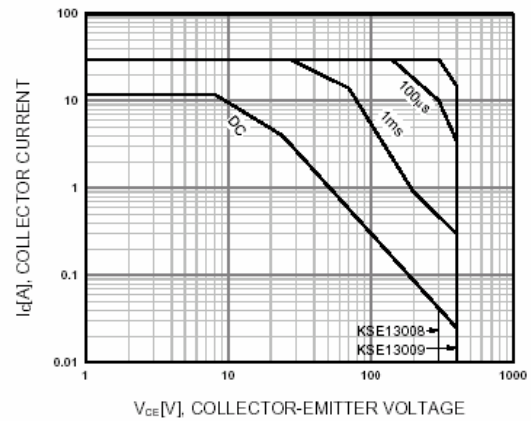


Figure 6. Safe Operating Area



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

HE13009

对应国外型号
KSE13009

特性曲线

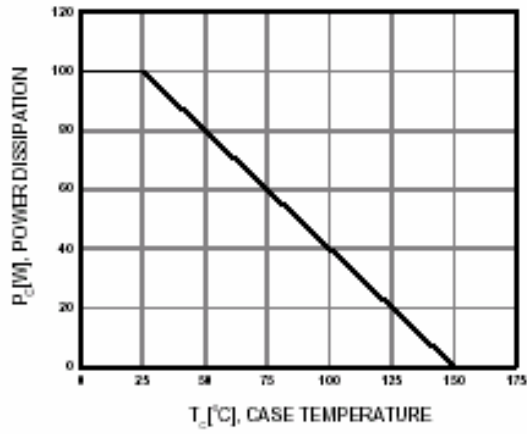


Figure 7. DC current Gain